

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОМА 43, 2014 г.

<i>Аржанова Н.А., Можяев А.В., Проказников А.В.</i> , Закономерности формирования фрактальных пористых кластеров в кремнии	3	212–227
<i>Аржанова Н.А., Проказников М.А., Проказников А.В.</i> , Процессы самоорганизации при электролитическом формировании наноструктур в полупроводниковых системах на основе кремния	6	441–455
<i>Афанасьева Д.Е., Звездин Н.Ю., Папорков В.А., Проказников А.В.</i> , Изменение магнитных свойств двумерных магнито-фотонных кристаллов световым воздействием	3	207–211
<i>Барбашов В.М., Трушкин Н.С., Елифанцев К.А.</i> , Использование вероятностных и нечетких моделей при моделировании радиационных отказов БИС	2	142–155
<i>Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Царик К.А., Чудинов А.А.</i> , Распределение ионов Ga ⁺ в кремниевой подложке для наноразмерного маскирования	1	23–28
<i>Борздов В.М., Борздов А.В., Сперанский Д.С., Вьюрков В.В., Орликовский А.А.</i> , Оценка эффективной пороговой энергии межзонной ударной ионизации в глубокосубмикронном кремниевом p-канальном МОП-транзисторе	3	188–192
<i>Боруздина А.Б., Григорьев Н.Г., Уланова А.В.</i> , Влияние топологического размещения ячеек в микросхемах памяти на кратность сбоев от ТЗЧ	2	88–93
<i>Бринкевич Д.И., Бринкевич С.Д., Вабищевич Н.В., Оджаев В.Б., Просолович В.С.</i> , Ионная имплантация позитивных фоторезистов	3	193–199
<i>Булгакова С.А., Гурова Д.А., Зайцев С.Д., Куликов Е.Е., Скороходов Е.В., Торопов М.Н., Пестов А.Е., Чхало Н.И., Салащенко Н.Н.</i> , Влияние полимерной матрицы и фотогенератора кислоты на литографические свойства химически усиленного фоторезиста	6	419–428
<i>Гольдштейн Р.В., Махвиладзе Т.М., Сарычев М.Е.</i> , Моделирование пространственно-неоднородной кислородной преципитации в кремнии с учетом внутренних механических напряжений	1	43–50
<i>Дунаев А.В.</i> , Исследование поверхности GaAs после травления в плазме смесей HCl/Ar, HCl/Cl ₂ , HCl/H ₂ методом атомно-силовой микроскопии	1	17–22
<i>Дунаев А.В., Мурин Д.Б.</i> , Электрофизические параметры и концентрации активных частиц в плазме смесей HCl с инертными и молекулярными газами	5	363–369
<i>Елесин В.В.</i> , Расчетно-экспериментальное моделирование эффектов мощности дозы в СВЧ МИС на основе гетероструктурных полевых транзисторов	2	133–141
<i>Ефремов А.М., Мурин Д.Б., Левенцов А.Е.</i> , Кинетика и режимы плазмохимического травления GaAs в условиях индукционного ВЧ разряда в CF ₂ Cl ₂	6	429–434
<i>Жуков В.А.</i> , Микро-системотехника и цифровая голографическая флэш-память	1	66–77

<i>Зенин В.В., Стоянов А.А., Петров С.В., Чистяков С.Ю.</i> , Сборка 3D-изделий с использованием проволочных выводов	1	29–42
<i>Катунин Ю.В., Стенин В.Я., Степанов П.В.</i> , Моделирование характеристик триггерных элементов КМОП двухфазной логики с учетом разделения заряда при воздействии отдельных ядерных частиц	2	104–117
<i>Ковалевский А.А., Строгова А.С., Строгова Н.С., Бабушкина Н.В.</i> , Исследование электрофизических свойств МДП-структур с пленками нитрида кремния, легированными редкоземельными элементами	4	250–255
<i>Коротков А.С.</i> , Методы калибровки и коррекции аналого-цифровых преобразователей (Обзор)	3	228–240
<i>Кузнецов В.С., Кузнецов П.А., Рудый А.С.</i> , Влияние генерации и рекомбинации носителей на вольтамперные характеристики полупроводниковых гетероструктур	3	180–187
<i>Лементуев В.А.</i> , К модели кольцевого генератора на КМДП инверторах	6	475–478
<i>Магунов А.Н., Захаров А.О., Лапишинов Б.А.</i> , Измерение температуры монокристаллов кремния методом спектральной пирометрии	3	200–206
<i>Маишев Ю.П., Шевчук С.Л., Кудря В.П.</i> , Исследование селективности травления различных материалов пучками быстрых нейтральных частиц	6	415–418
<i>Маишев Ю.П., Шевчук С.Л., Кудря В.П.</i> , Формирование пучков быстрых нейтральных частиц на основе источников ионов с замкнутым дрейфом электронов	5	355–362
<i>Мартюшев С.Г., Шеремет М.А.</i> , Два фактора, влияющие на интенсивность охлаждения тепловыделяющих элементов в герметичных блоках	5	390–398
<i>Масальский Н.В.</i> , Частотные характеристики широкополосного субмикронного КНИ фотонного фазового модулятора	5	384–389
<i>Никифоров А.Ю., Скоробогатов П.К., Егоров А.Н., Громов Д.В.</i> , Выбор оптимальных параметров лазерного излучения для моделирования ионизационных эффектов в кремниевых микросхемах объемной технологии	2	127–132
<i>Новиков Ю.А.</i> , Виртуальный растровый электронный микроскоп. 3. Полуэмпирическая модель формирования сигнала РЭМ	4	263–274
<i>Новиков Ю.А.</i> , Виртуальный растровый электронный микроскоп. 4. Реализация на основе симулятора	6	456–467
<i>Новиков Ю.А.</i> , Плотность распределения электронов в зонде низковольтного РЭМ	5	373–383
<i>Ожегин Ю.А.</i> , Методика анализа эквивалентности рентгенограмм микросхем для задач оценки радиационной стойкости	4	315–320
<i>Орлов О.М., Горнев Е.С., Шадрин А.В., Зайцев С.А., Морозов С.А., Заблоцкий А.В.</i> , Эффект резистивного переключения в структурах $TiN/Hf_xAl_{1-x}O_y/HfO_2/TiN$ и $TiN/HfO_2/Ti/TiN$	5	337–342
<i>Орлов О.М., Чуприк А.А., Батулин А.С., Горнев Е.С., Булах К.В., Егоров К.В., Кузин А.А., Незров Д.В., Зайцев С.А., Маркеев А.М., Лебединский Ю.Ю., Заблоцкий А.В.</i> , Ячейка энергонезависимой памяти на эффекте резистивного переключения в оксидных пленках $Hf_xAl_{1-x}O_y$	4	243–249

<i>Подвигалкин В.Я., Ушаков Н.М.</i> , Резистивные и емкостные структуры толстых пленок для микросборок на основе полимерных нанокomпозиционных материалов	1	3–8
<i>Подвигалкин В.Я.</i> , Формирование архитектуры наноразмерных полимерных сред с квантовыми точками	4	275–281
<i>Подгорный Ю.В., Вишневский А.С., Воротилов К.А., Лавров П.П., Ланцев А.Н.</i> , Электрофизические свойства пленок ЦТС, легированных лантаном	6	468–474
<i>Рудаков В.И., Овчаров В.В., Лукичев В.Ф., Денисенко Ю.И.</i> , Исследование диффузии бора, фосфора и мышьяка в кремнии при отжиге в неизотермическом реакторе	4	289–304
<i>Рудый А.С., Куликов А.Н., Куликов Д.А., Метлицкая А.В.</i> , Высокомодовые волновые рельефы в рамках пространственно-нелокальной модели эрозии	4	282–288
<i>Скоробогатов П.К.</i> , Лазерное имитационное моделирование за дифракционным пределом	2	118–126
<i>Согоян А.В., Черепко С.В., Першенков В.С.</i> , Водородно-электронная модель накопления поверхностных состояний на границе раздела окисел–полупроводник при воздействии ионизирующего излучения	2	156–158
<i>Сокол В.А., Яковцева В.А.</i> , Гидродинамика электролита в порах анодного оксида алюминия	5	370–372
<i>Солодуха В.А., Турцевич А.С., Соловьев Я.А., Комаров Ф.Ф., Мильчанин О.В., Ковалева Т.Б., Гапоненко С.В.</i> , Формирование барьеров Шоттки на основе никель-платинового силицидного сплава	1	9–16
<i>Стенин В.Я.</i> , Ограничения и перспективы использования двухфазной КМОП-логики в сбоеустойчивых суб-100-нм СБИС	2	94–103
<i>Фадеев А.В., Руденко К.В.</i> , Верификация алгоритма эмиссионной томографии плазменных неоднородностей в плазмохимическом реакторе с помощью лэнгмюровского мультисонда	4	256–262
<i>Фадеев А.В., Руденко К.В.</i> , Исследование латерального распределения частиц VF_3 плазмы с помощью двухракурсной эмиссионной томографии	6	435–440
<i>Хомяков А.Н., Вьюрков В.В.</i> , Полуаналитическая модель полевого транзистора на основе нанопроволоки	1	51–65
<i>Цуканов А.В., Катеев И.Ю.</i> , Квантовые вычисления на квантовых точках в полупроводниковых микрорезонаторах. Часть I	5	323–336
<i>Цуканов А.В., Катеев И.Ю.</i> , Квантовые вычисления на квантовых точках в полупроводниковых микрорезонаторах. Часть II	6	403–414
<i>Цуканов А.В.</i> , Квантовые точки в фотонных молекулах и квантовая информатика. Часть II	3	163–179
<i>Чумаков А.И.</i> , Оценка многократных сбоев в интегральных схемах от воздействия тяжелых заряженных частиц	2	83–87
<i>Эминов П.А., Соколов В.В., Гордеева С.В.</i> , Плазма полупроводниковой нанотрубки	5	343–354

<i>Яфаров Р.К., Климова С.А.</i> , Модификация электронных свойств поверхности кристаллов кремния (100) при СВЧ-плазменной микрообработке	4	305–314
Авторский указатель тома 42, 2013 г.	1	78–80
Вниманию авторов	2	159–160
Вниманию авторов	5	399–400
Вниманию авторов	6	479–480